

证书号第670055号



发明专利证书

发明名称：一种增强型 AlGaIn/GaN 场效应管及其制作方法

发明人：刘扬；江灏；文于华；张佰君；王钢

专利号：ZL 2009 1 0036617.8

专利申请日：2009 年 01 月 13 日

专利权人：中山大学

授权公告日：2010 年 09 月 08 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 01 月 13 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



证书号第1168371号



发明专利证书

发明名称：一种功率型 AlGaIn/GaN 肖特基二极管及其制作方法

发明人：刘扬;李佳林;贺致远;张佰君;王钢

专利号：ZL 2009 1 0193179.6

专利申请日：2009 年 10 月 20 日

专利权人：中山大学

授权公告日：2013 年 04 月 03 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 10 月 20 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



证书号第 1064761 号



发明专利证书

发明名称：一种功率型 GaN 基肖特基二极管及其制作方法

发明人：刘扬；贺致远；李佳林；张佰君

专利号：ZL 2010 1 0529792.3

专利申请日：2010 年 10 月 29 日

专利权人：中山大学

授权公告日：2012 年 10 月 17 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 10 月 29 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



证书号第 1031003 号



发明专利证书

发明名称: GaN 基异质结构增强型绝缘栅场效应晶体管及制备方法

发明人: 刘扬; 许广宁; 沈震

专利号: ZL 2010 1 0617606.1

专利申请日: 2010 年 12 月 31 日

专利权人: 中山大学

授权公告日: 2012 年 08 月 29 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查, 决定授予专利权, 颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年, 自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 12 月 31 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的, 专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



证书号第 1311198 号



发明专利证书

发明名称：一种 GaN 基增强型 MOSFET 器件的制备方法

发明人：刘扬；姚尧；张佰君

专利号：ZL 2011 1 0321887.0

专利申请日：2011 年 10 月 20 日

专利权人：中山大学

授权公告日：2013 年 11 月 27 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 10 月 20 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



证书号第1253201号



发明专利证书

发明名称: GaN 高阈值电压增强型 MOSFET 器件及制备方法

发明人: 刘扬; 沈震; 张佰君

专利号: ZL 2011 1 0339435.5

专利申请日: 2011 年 11 月 01 日

专利权人: 中山大学

授权公告日: 2013 年 08 月 14 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查, 决定授予专利权, 颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年, 自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 11 月 01 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的, 专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



证书号第1645909号



发明专利证书

发明名称：一种混合结构场效应晶体管及其制作方法

发明人：刘扬；魏进；姚尧

专利号：ZL 2012 1 0416073.X

专利申请日：2012年10月26日

专利权人：中山大学

授权公告日：2015年04月22日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月26日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第1692967号



发明专利证书

发明名称：一种 GaN 增强型 MIS-HFET 器件及其制备方法

发明人：刘扬；张金城；贺致远；张佰君

专利号：ZL 2012 1 0381515.1

专利申请日：2012 年 10 月 10 日

专利权人：中山大学

授权公告日：2015 年 06 月 10 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 10 月 10 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 1486584 号



发明专利证书

发明名称: 纵向导通的 GaN 基 MISFET 器件及其制作方法

发明人: 刘扬; 倪毅强; 张佰君

专利号: ZL 2012 1 0033746.3

专利申请日: 2012 年 02 月 15 日

专利权人: 中山大学

授权公告日: 2014 年 09 月 24 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查, 决定授予专利权, 颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年, 自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 02 月 15 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的, 专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 942854 号



发明专利证书

发明名称：用于氮化物外延生长的纳米级图形化衬底的制备方法

发明人：张佰君；饶文涛

专利号：ZL 2009 1 0042058.1

专利申请日：2009 年 08 月 21 日

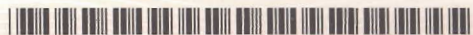
专利权人：中山大学

授权公告日：2012 年 05 月 09 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 08 月 21 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



证书号第 1276880 号



发明专利证书

发明名称：一种硅衬底上半极性、非极性 GaN 复合衬底的制备方法

发明人：张佰君；向鹏

专利号：ZL 2011 1 0101683.6

专利申请日：2011 年 04 月 22 日

专利权人：中山大学

授权公告日：2013 年 09 月 25 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 04 月 22 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



证书号第821343号



发明专利证书

发明名称：基于预成型阳极氧化铝的亚微米图形衬底制作方法

发明人：张佰君;黄智聪;王钢

专利号：ZL 2009 1 0192331.9

专利申请日：2009年09月15日

专利权人：中山大学

授权公告日：2011年08月10日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年09月15日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



证书号第 1662318 号



发明专利证书

发明名称：一种渐变 AlGa_N 层的制备方法及采用该方法得到的器件

发明人：张佰君;杨亿斌

专利号：ZL 2013 1 0040189.2

专利申请日：2013 年 02 月 01 日

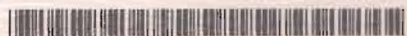
专利权人：中山大学

授权公告日：2015 年 05 月 13 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 02 月 01 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 805716 号



发明专利证书

发明名称：一种双元素 delta 掺杂生长 P 型 GaN 基材料的方法

发明人：江灏；陈计林

专利号：ZL 2009 1 0192129.6

专利申请日：2009 年 09 月 08 日

专利权人：中山大学

授权公告日：2011 年 07 月 06 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 08 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



2011 年 07 月 06 日